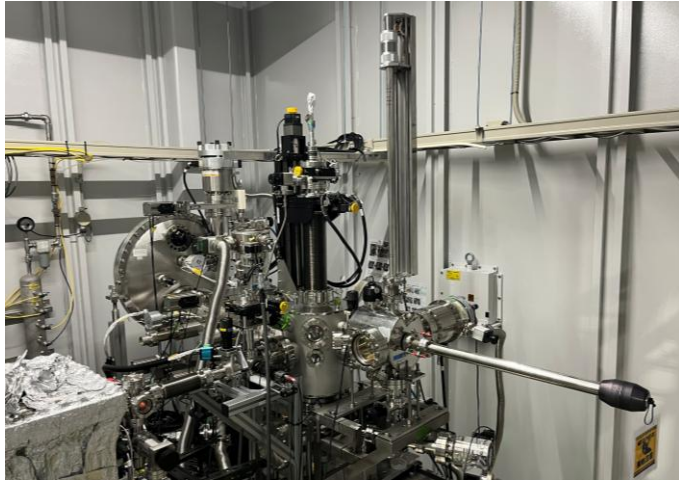
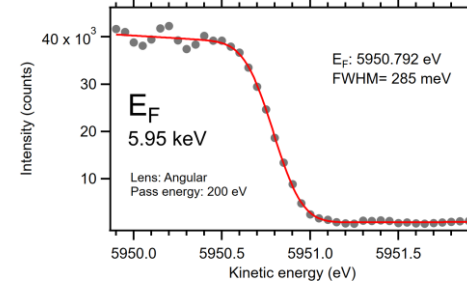
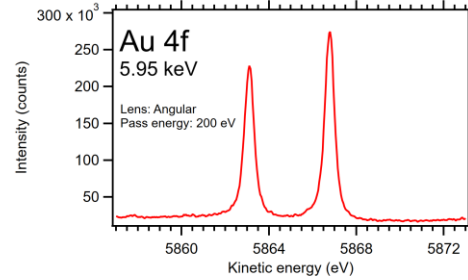


2026年3月末にAP-HAXPES装置を設置し、以下のテスト結果を得ました。本資料末尾の通り、ご利用可能な状態となっています。

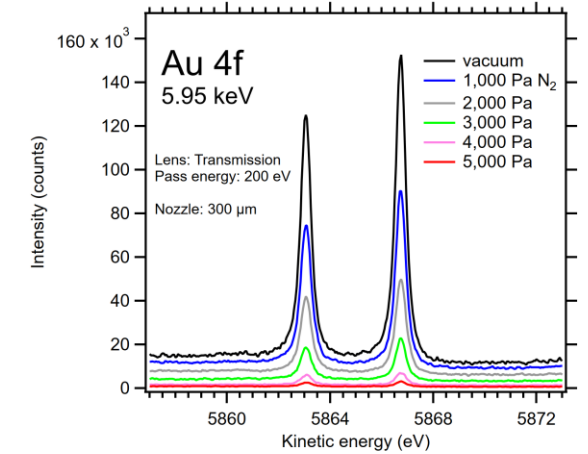


UHV環境におけるAP-HAXPES装置の性能評価



- 従来分析器と同等程度の光電子強度と分解能を確認
- 窒素ガス5,000 PaでのAP-HAXPES測定が可能であることを確認
⇒ 1気圧 (1×10^5 Pa) への高圧化を実施中

N₂ガス雰囲気でのAP-HAXPES測定



現在の利用について

- **従来と同様のHAXPES測定** ($E = 5.95$ keV) を実施できます。
 - アナライザー先端からサンプル表面までのWDは10 mmです。
 - 従来から要望のある**8 keVでの測定もオプション**として対応します (**予約前の相談必須**)。
 - ※ この場合に必要な光学調整 (1時間前後) はご予約いただいたビームタイム内で実施します。
 - ※ 8 keVは現時点ではTransmission modeのみであり、試験運用であることをご理解ください。
- **ガス雰囲気でのAP-HAXPES測定**を実施できます (**予約前の相談必須**)。
 - 利用できるガスは現時点では不活性ガス (N₂, Ar) に限ります。
 - COやNOなどの有毒ガスは、ガス除害装置の設置後に利用可能となります (2027年度の予定)。
 - WDは分析器に取り付ける差動排気コーンの開口に依存します。標準的なコーンの場合、約0.3 mmです。

【ガス雰囲気での適用例】 N₂ガスからの電荷補償を利用した 絶縁体 (SiO₂) のAP-HAXPES測定

